

# 2SD733, 733K 2SB697, 697K

低周波電力増幅用

NPN / PNP Epitaxial Mesa Type Silicon Transistor

For AF Power Amplifier Use



2017

- ★ A complementary pair.
- ★ For output stage of 80 watts power amplifier.
- ★ High voltage, large current ability.
- ★ ( ) shows 2SB697, -K only.

© C468D

特長 ・高耐圧である。 ・オーディオ 80 W 出力用。  
 ・大電流である。

( )内は 2SB697, 697K の場合を示す。

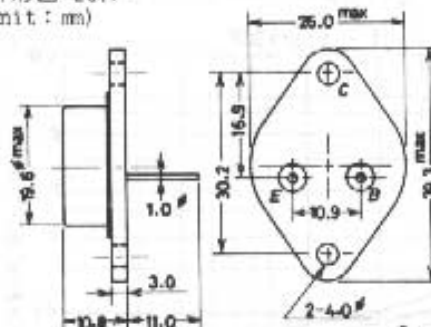
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		2SB697, 2SD733	2SB697K, 2SD733K	unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-)160	(-)180	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-)140	(-)160	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$		(-)6	V
コレクタ電流	$I_C$	(-)12		A
ピークコレクタ電流	$I_{cp}$	(-)20		A
コレクタ損失	$P_C$		100	W
接合部温度	$T_j$		150	$^\circ\text{C}$
保存周囲湿度	$T_{stg}$		-40~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$ $V_{CB} = (-)80\text{V}, I_B = 0$		(-)0.1		mA
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$ $V_{EB} = (-)4\text{V}, I_C = 0$		(-)0.1		mA
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ ※ $V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)1\text{A}$	40		320	
	$h_{FE(2)}$ $V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)5\text{A}$	20			
利得帯域幅積	$f_T$ $V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)1\text{A}$		15		MHz
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$ $V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)1\text{A}$		(-)1.5		V
C-B 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C = (-)6\text{A}, I_B = (-)0.6\text{A}$		(-1.0) (-2.5)		V
			0.7	2.5	V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$ $I_C = (-)5\text{mA}, I_E = 0$		(-)160		V
			(-)180		V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CB0(1)}$ $I_C = (-)5\text{mA}, R_{BE} = \infty$		(-)140		V
			(-)160		V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CB0(2)}$ $I_C = (-)50\text{mA}, R_{BE} = \infty$		(-)140		V
			(-)160		V
E-B 降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$ $I_B = (-)5\text{mA}, I_C = 0$		(-)6		V

※ 2SB697, 2SD733は 1A  $h_{FE}$  によりつぎのように分類している。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2017  
(unit: mm)



EIAJ: TC-3, TB-3  
JEDEC: TO-3

C: Collector  
E: Emitter  
B: Base